SPICE Simulator Kullanarak Kazanç Anahtarlama Yöntemiyle Çok Kısa Süreli Darbe Üretimi

Nuran Dogru ve M. Sadettin Ozyazici Gaziantep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Gaziantep <u>dogru@gantep.edu.tr</u>, sadi@gantep.edu.tr

Özet: Üç-seviye oran (three-level rate) denklemlerine dayanan kuantum kuyu (QW) laserin kazanç anahtarlama (gain-switched) karakteristikleri ilk defa SPICE eşdeğer devre modeli kullanarak tanımlanmıştır. Bazı laser diyot parameterelerinin, dc ve rf akımlarının kazanç anahtarlama darbelerinin full-width half maximum (FWHM) üzerine etkisi incelenmiştir. Darbelerin, FWHM u rf akımı artarıldığında azalırken, dc akımın artmasıyla arttığı gösterilmiştir. FWHM ayrıca kazanç doyma parameteresinin (gain saturatin parameter) küçük değerleri için azalmıştır. Bununla birlikte, kuyudaki taşıyıcı zamandaki (carrier lifetime) değişiklikler FWHM u önemli derecede etkilememiştir.

1. Giriş

Yarı iletken lazer diyotlar yüksek hızdan düşük hıza değişen bir çok uygulamalarda anahtar elemandır. Bu uygulamalar arasında, kritik sorun sistem desinatörüne yarıiletken lazer diyotun eşdeğer devre modeli gereksiniminin sağlanmasıdır. Bu nedenle, özel uygulamalar için bu lazer diyot ve onun sürücü devresi güç kontrolü (power control), yavaş başlangıç (slow start), modülasyonu (modulation) gibi) uygun bir şekilde yaptırılabilir. Bir çok yazar çift heterojonksiyon (double heterojunction-DH) için çeşitli lazer eşdeğer devre modelleri önermiştir [1-2]. Bu modelleri kullanarak yarı iletken lazer diyotun geçici tepkisi (transient response), küçük sinyal tepkisi (small signal response), ve mikrodalga karakteristikleri (microwave characteristics) incelenmiştir. Bu çalışmada ise, kuvantum kuyu (QW) lazerin kazanç anahtarlama karakteristikleri ilk defa SPICE eşdeğer devre [3] modeli kullanılarak ele alınmıştır. Kazanç anahtarlama aşırı kısa darbe üretimi için en basit metot olarak bilinir. Pasif ve aktif mode-kilitlemede olduğu gibi dış boşluğa (external cavity) ve dikkatli hizaya gerek yoktur [4].

Bu çalışmada, bazı lazer diyot parametrelerinin ve dc ve rf akımlarının, SPICE simulator kullanarak kazanç anahtarlama yöntemiyle üretilen darbelerin full-width half maximum (FWHM) üzerine etkisi inclendi. Sonuçlar, sabit bir frekansda darbelerin FWHM nın rf akımının artmasıyla azaldığını ama dc akım artarken arttığını gösterdi. FWHM bir de kazanç doyma parametresinin küçük değerleri için azalırken kuyu içindeki taşıyıcı zamandaki (carrier lifetime) değişikliklerin FWHM u önemli derecede etkilemediği gözlenmiştir.

2. Modelleme

Üç-seviye oran (three-level rate) denklemlerinin eşdeğer devre gösterimi Şek. 1 de verilmiştir. G ile nitelendirilen elemanlar akım kaynakları ve E ile nitelendirilenler voltaj kaynaklarıdır. Zaman türevleri G1, G4 ve G7 ile gösterilmiştir. I(VIS), I(VIG), ve I(VIQ) akımları I_S, I_G, ve I_Q akımlarını göstermektedir. Şek. 1 de gösterildiği gibi altdevrelerde kapasitorlerle gösterilen spontane birleşim zamanları (sponatenous recombination times) sabit olarak alınmıştır. Bu taşıyıcı konsantrasyonun bağmlı proses olduğu demektir. Bununla birlikte, pratikte bölgesel taşıyıcı yoğunlukların özelliklede QW içinde eşik yukarısında önemli derecede değişmez. Bu nedenle, burada kullanılan τ' lar için sabit değerler uygun ortalama değerleri olarak görülür.

3. Numerik Sonuçlar

SPICE programı Tablo 1 de verilen parametreler için çalıştırıldı.Bu şartlar altinda lazer diyodun eşik akımı 10.5 mA ve ilgili bias akımı I_{bias} 38 mA dir.

Şek. 2 üretilen darbelerin FWHM değişiminin aynı parametre değerleri için kazanç doyma parametreli (ϵ) ve kazanç doyma parametresiz, uygulanan dc biyas akımının bir fonksiyonu olarak göstermektedir. Uygulanan rf akımı minimum darbe genişliği elde etmek için her dc biyas akımı için ayarlanmıştır. Şek. 2 kazanç doyma parametresinin darbe genişliği üzerine etkisini açıkca göstermektedir. Sabit dc biyas akımda I_b=I_{th}, kazanç



Şekil. 1 Uç-seviye oran denklemlerinin SPICE eş devre gösterimi. C1=
$$\tau_{ns}$$
, C2= τ_{nG} , C3= τ_{nQ} , G1=I(V11),
G2= $\frac{\tau_{nS}}{\tau_D}$ I(VIS), G3= $\frac{\tau_{nG}}{\tau_G}$ I(VIG), G4=I(V12), G5= $\frac{\tau_{nG}}{\tau_C}$ I(VIG), G6= $\frac{\tau_{nQ}}{\tau_{ESC}}$ I(VIQ), G7=I(VI3),
GSPON= β I(VIQ), E1=I(VIS), E2=I(VIG), E3=I(VIQ)

doyma parametresiyle lazer diyot, süresi 26 ps olan optikal darbe üretir. Eğer kazanç doyma parametresi dikkate alınmazsa aynı dc biyas akım 19 ps lık optikal darbe üretir. Sonuç olarak, darbe genişliği kazanç doyma parametresiyle genişler. Ayrıca, çift darbeler elde etmeden uygulanabilecek maksimum bir dc bias akım olduğunu da belirtmek gerekir. Kullanılan parametreler için lazer diyoda uygulanan maksimum dc akım 11_{th} olarak bulunmuştur. Şek. 2 de görüldüğü gibi dc akımın azalmasıyla darbe genişliği azalmaktadır. Darbelerin dc akımla FWHM deki benzer değişimi Ref. 4 te kazanç doyma parametresi dikkate alınarak gösterilmiştir.

Tablo 1 Simulasyonda kullanılan model parametreleri

Parameter	Value	Unit
τ_{ns}	1	ns
τ_{nG}	1	ns
$ au_{nQ}$	0.35	ns
$ au_{\mathrm{D}}$	48.3	ps
τ_{G}	1	ps
$\tau_{\rm C}$	0.18	ps
$ au_{ESC}$	200	ps
$ au_{\mathrm{P}}$	3.02	ps
Г	0.019	
Vg	7.5×10^{7}	ms ⁻¹
Eр	6.3x10 ⁻⁸	
\overline{p}	3.03x10 ⁻⁸	W
β	1x10 ⁻⁴	
CJ	140	fF

Şek. 3 FWHM deki değişimi uygulanan rf akımının bir fonksiyonu olarak göstermektedir. Bu durumda, minimum darbe genişliği elde etmek için dc akım her rf akımı için ayarlanmıştır. Yine kazanç doyma parametresinin darbe genişliği üzerine etkisi Şek. 3 te açıkca görülmektedir. Ayrıca, çoklu-darbe üretilmeden lazer diyoda uygulanacak maksimum bir rf akımı vardır. Maksimum rf akımı kazanç doyma parametreli ve parametresiz 9I_{th} olarak bulunmuştur. Her iki durumda da Ref. 5 de olduğu gibi darbelerin FWHM i rf akımı artarken azalmıştır. Şek. 3 de görüldüğü gibi kazanç doyma paremetreli darbe genişliği 47.64 ps ve kazanç



doyma paremetresiz dabe genişliği 42.38 ps dır. Şekilde de gözlendiği gibi kazanç doyma paremetresi yüzünden darbe genişliği artmaktadır.

Şekil 2 Darbelerin FWHM nın dc biyas akımla değişimi

Şekil 3 Darbelerin FWHM nın rf akımla değişimi

Bu çalışmada, kuyu içindeki taşıyıcı zaman (τ_{nQ}) çok az değiştirilmiştir. 0.35 ns dan 0.23 ns a değişen bu parametrenin FWHM üzerine etkisi Şek. 4 te verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi kazanç doyma parametreli ve parametresiz bu parametre FWHM mu önemli derecede etkilememektedir. Bununla birlikte, eşik akımını etkilemektedir. τ_{nQ} =0.23 ns için eşik akımı 12.16 mA olarak bulunmuştur.



Şekil 4 Taşıycı zamandaki (τ_{nQ}) değişimin FWHM üzerine etkisi

4. Sonuç

İlk defa SPICE simulator kullanarak kazanç anahtarlamayla pikosaniyeli darbelerin üretimi tanımlanmıştır. Kısa darbe üretimi için esas sınırlamanın beklenildiği gibi kazanç doyma parametresi olduğu gösterilmiştir. Darbe genişliği kazanç doyma parametresiyler genişler. Ayrıca, FWHM in rf akımı artarken azaldığı, buna rağmen dc akımın artmasıyla arttığı bulunmuştur.

Kaynaklar

- R. S Tucker, "Large signal circuit model for simulation of injection laser modulation dynamics," IEE Proc.-I, 128, s. 180-184, 1981
- [2] R. S Tucker, "Circuit model of double heterojunction laser below threshold, IEE Proc.-I," 128, s. 101-106, 1981.
- [3] B. P. C. Tsou, D. L. Pulfrey, "A versatile SPICE model for quantum-well lasers," IEEE J. Quantum Electron., 33, s. 246-254, 1997.
- [4] M. S. Ozyazici ve M. S. Demokan, "Gain-switched pulse generation from a 1.55 μm InGaAsP laser," International Journal of Optoelectronics, 5, s. 7-30, 1990.
- [5] M. Sayin ve M. S. Ozyazici, "Effect of gain switching frequency on ultrashort pulse generation from laser diodes," Opt. Quant. Electron., s. 29, 627-638, 1997.